ミリ波通信の実用化に向けた RF・AD混載集積回路技術

松澤昭

東京工業大学 大学院理工学研究科





- ・はじめに
- ・ 60GHz CMOS トランシーバの概要
- 60GHz CMOS RF回路設計のポイント
- · 超高速·低電力ADC
- 38GHz アウトドアシステム
- 東工大ミリ波モデルネットワーク

はじめに

ミリ波システムと集積回路開発の背景



総務省ミリ波プロジェクト

屋内(--10m) および屋外(1km~4km)のミリ波システム およびSoCの開発によりミリ波利用を促進する

FY2007-FY2011

- 1. 60GHz, Indoor 3-10 Gbps -- 10m
- BB MODEM SoC 40nCMOS
- 2. 38GHz, Outdoor 0.6-1.0Gbps 1km – 4km





線通信量の急増

TOKYO TECH **Pursuing Excellence**

スマホの通信量は従来携帯の20倍程度に増加する

居司

比4%増の3400億円 止まり、12年度は10年度

を投じる。米アップルの

iPhone(アイフォ

ノ)発売で増えたデー

2012年(平成24年)1月7日(土曜日)

携帯電話大手が201

K

コモ

基

地

同

を

○日本経

トフォン通信急増

急ぐ。 る。スマー 局や基幹通信網の増強を 強まっており、高速基地 増で回線不足への懸念が の普及に伴う通信量の急 機能携帯電話=スマホ) 年連続で1割前後増え 兆6000億円超と、3 関連事業向けの合計は1 (スマー トフォン(高 トフォン

3 12

下支えしそうだ。

の普及は3面 「きょうの 民間投資を携帯向けが下支え

通信大手3社の投資額 1.6 - (注)ドコモ、KDDI(au)、ソフト バンクの合計。12年度は 一部推定

を加えた大手3社の携帯 前年度比約5割増やす見 積みし、ソフトバンクは 初計画に300億円を上 する。 NTTドコモは当 2年度の設備投資を拡大 (a u 割增

通し。 KDDI

引役で、設備投資全体の が約6割を占め、 0億円。携帯3社の投資 の設備投資は2兆400 並ぶ民間設備投資のけん 1割弱を占める。10年度 今後も いる。ほとんどを国内に

計画だったが、通信量の

投じる携帯向け投資の拡 大基調は民間設備投資を 10年度で同じ 局整備の一巡で減少傾向 る。13年度以降も増強をビスの基地局を増設す 電波の利用効率を3倍 維持する。 %と全国に広げる。 通信エリアを人口比で98 で5500億円を投じ、 で高速携帯向け設備だけ 続け、15年度までの3年 11年度に近い投資水準を 0億円程度を上積みし、 auの設備投資は基地

12年度1

急増などに対応し当初計

画の4%に相当する3

Ō

通信業界は電力業界と きに不透明感が強まって 速に加え、 拡大が見込まれる。 く2兆4000億円の電 の生産拠点の海外移転加

える見込み。12年度は10 年度比で約600億円増 年度以前の水準に減らす 投資は7280億円と10 ドコモの11年度の設備

兆円

1.0

結果、通信量は従来型携 画像や動画を見たり、ゲ じように、ネット経由で ムを楽しんだりできる はドコモのスマホでメー 用者の急増で11年12月に ルが誤表示されるなどの - 率は10年度末には57・1 ・ 1 によると、国内の携帯電 %まで拡大する見通し。

増える見通し。既存の携

けなどの投資が膨らむ。

模と、11年度比5割程度 備投資は6000億円規 の12年度の携帯関連の設

高速無線通信サービス向に本格的に開始する次世

夕通信需要に対応する。

ソフトバンクグループ

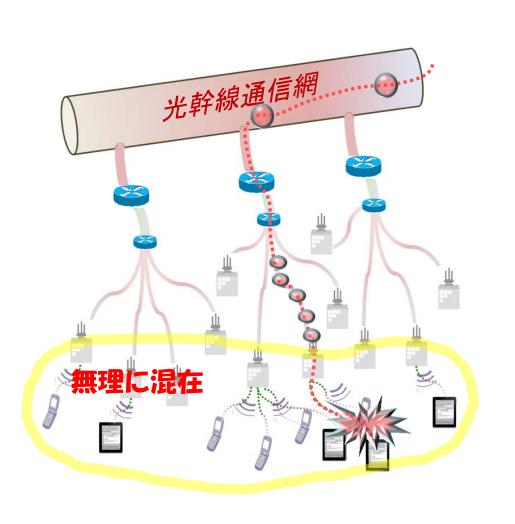
Matsuzawa & Okada Lab.

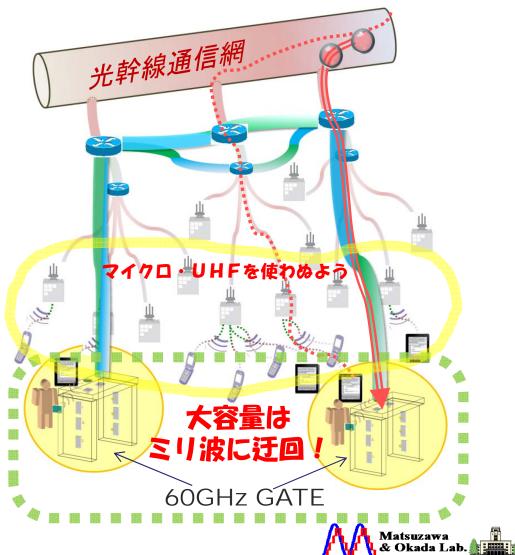


背景:無線回線の逼迫

スマートフォンやクラウドコンピューティングの普及などにより、無線通信のデータ量が急増。

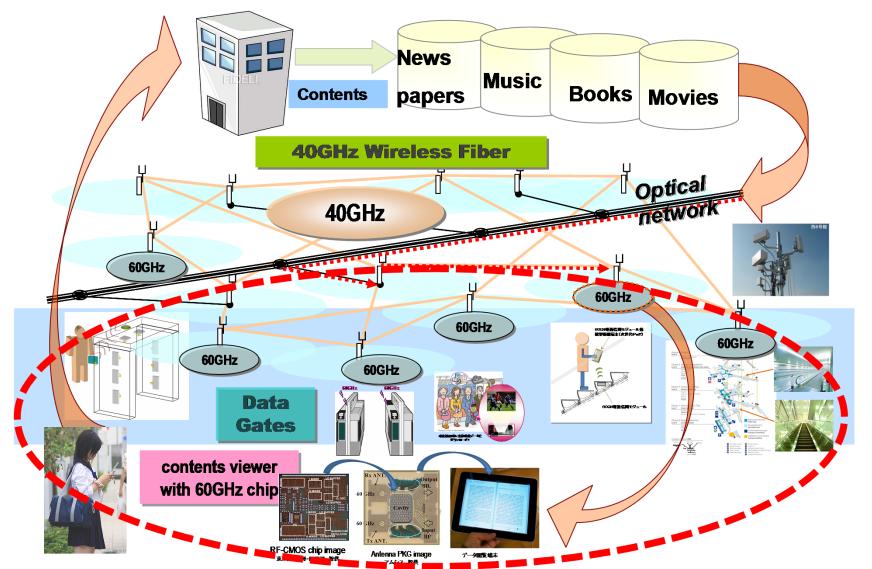
大容量データはミリ波回線に迂回するべきではないか





ミリ波ネットワークの将来イメージ

ミリ波は機器間でのデータ転送に使用されるだけでなく、WiFi、WiMaxの基地局間同士を接続するとともに「ミリ波ゲート」を通過する間に必要なデータを転送できる

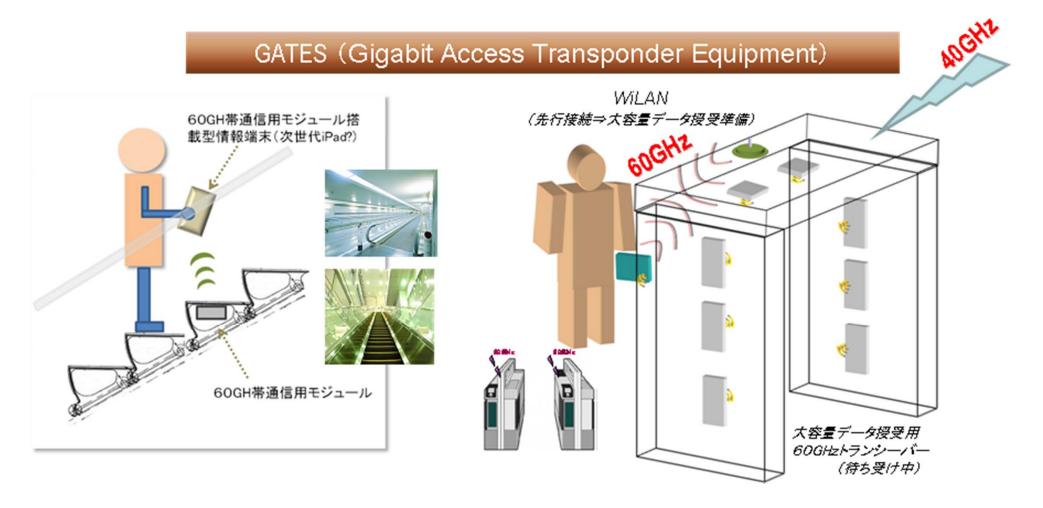


TOKYO TECH

Pursuina Excellence

ミリ波ゲート

ミリ波は直進性が高いため、デバイスを対向させないと通信できない。 しかし、データ伝送が高速なため、瞬時のデータ転送が可能である。 そこで、「ゲート」を設け、そこを通過するときにデータ転送を行ってはどうか?





プロジェクトメンバーと役割

東工大3研究室と5つの企業の産学連携プロジェクト

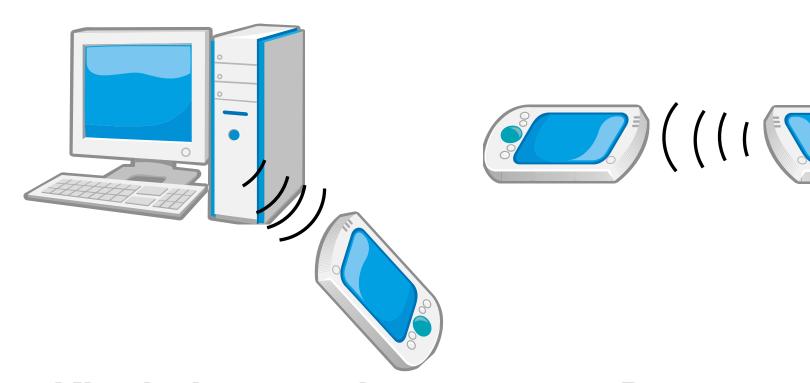
Indoor wireless access system **Outdoor** entrance systems (Sony) (JRC) Mm-wave CMOS Rx/Tx chip and base band ADC/DAC. (松澤・岡田研) Phase noise reduction by DSP **GaN HPA** (鈴木・府川研) (NEC) Packaging, MMIC, RF-module (AMSYS) **High Gain Arrays Antennas on PCB / Chip** (安藤・広川研) (安藤・広川研) **Propagation Test** プロジェクトリーダ: 安藤教授 (Willcom)



60GHz CMOSトランシーバの概要

利用モデル

ギガビット機器間データ伝送の実現 瞬時のデータトランスファーを狙い、小型、低電力



Kiosk download

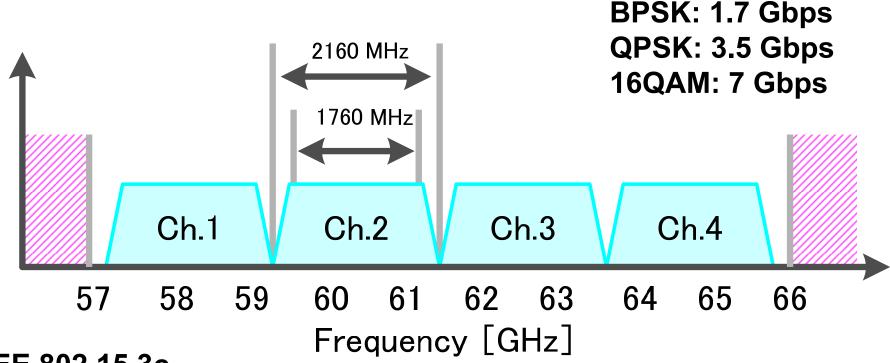
Peer-to-peer



60GHz帯の周波数プラン

帯域約1.8GHz, 4チャンネル

- ・チャネル内の周波数特性の均一化
- ・57GHz~66GHzまでの周波数帯域での特性均一化



IEEE 802.15.3c

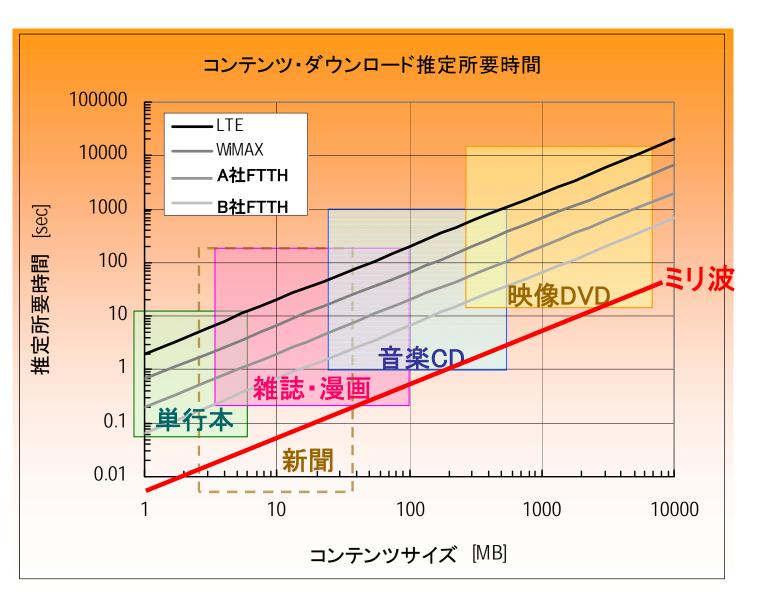
IEEE 802.11ad

802.15.3c-2009, IEEE Std., Oct. 2009. [Online]. Available http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.3c-2009.pdf



各種コンテンツの転送に要する時間

ミリ波を用いれば無線でも約10秒でDVDのコンテンツが転送可能



2011年1月現在の 実測データからみた 平均的実効伝送レート								
WiMAX	12	Mbps						
LTE	4	Mbps						
A社FTTH	40	Mbps						
B社FTTH	120	Mbps						

ミリ波 3~6Gbps

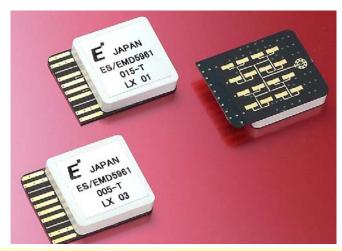


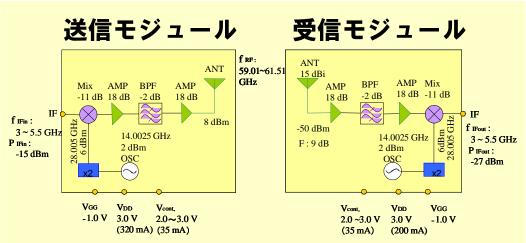
TOKYO TECH

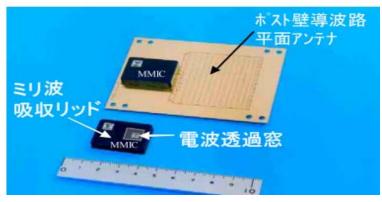
Pursuing Excellence

従来のミリ波システム

2006年にはGaAs技術を用いて60GHzのモデュールが完成していたしかしながら、更なるコストダウンが必要だった他、ベースバンドチップが無く、データ伝送速度は50Mbps程度であった。











データレート向上の取り組み

多値QAMの採用と広帯域化

データレート $\approx N \times BW$

これまでの実績

QPSK (N=2), BW=1.7GHz \rightarrow DR=3.4Gbps 16QAM (N=4), BW=1.7GHz \rightarrow DR=6.8Gbps 16QAM (N=4), BW=4.0GHz \rightarrow DR=16Gbps

今後の計画

64QAM (N=6), BW=4.0GHz → DR=24Gbps 64QAM (N=6), BW=8.0GHz → DR=48Gbps

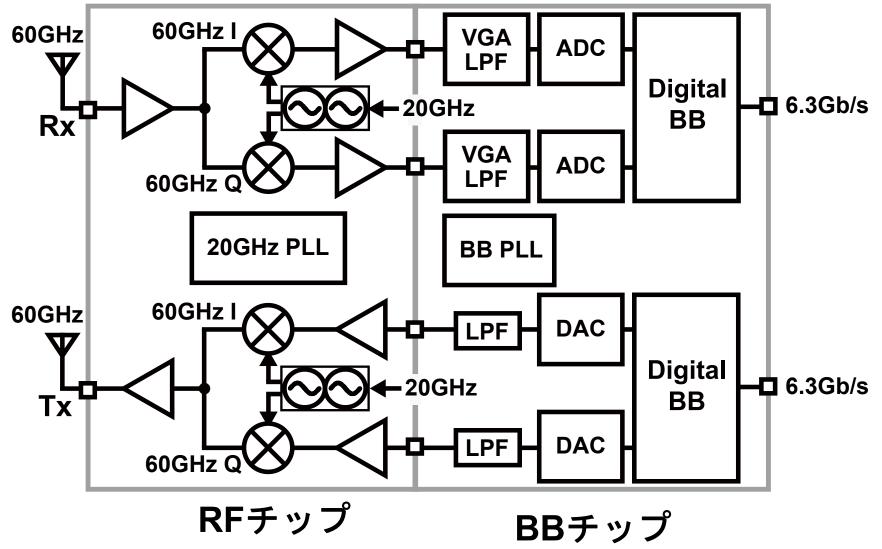
技術課題と対策

広帯域化: RF回路とBB回路の広帯域化, ゲインフラット化, ADCの高速化高SNR: アンテナ利得の向上, フロアノイズの減少, ADC分解能の向上低位相ノイズ: インジェクションロック技術の向上, インダクタのQの向上



60GHz CMOSトランシーバー

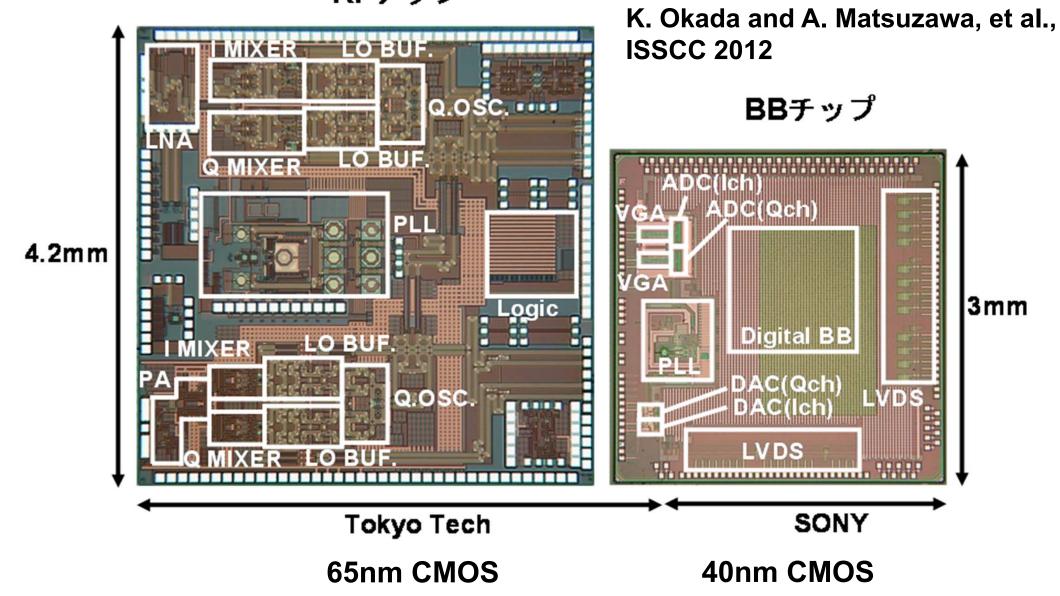
- ダイレクトコンバージョン型による小型・低消費電力化
- 低消費電力ADC, DAC



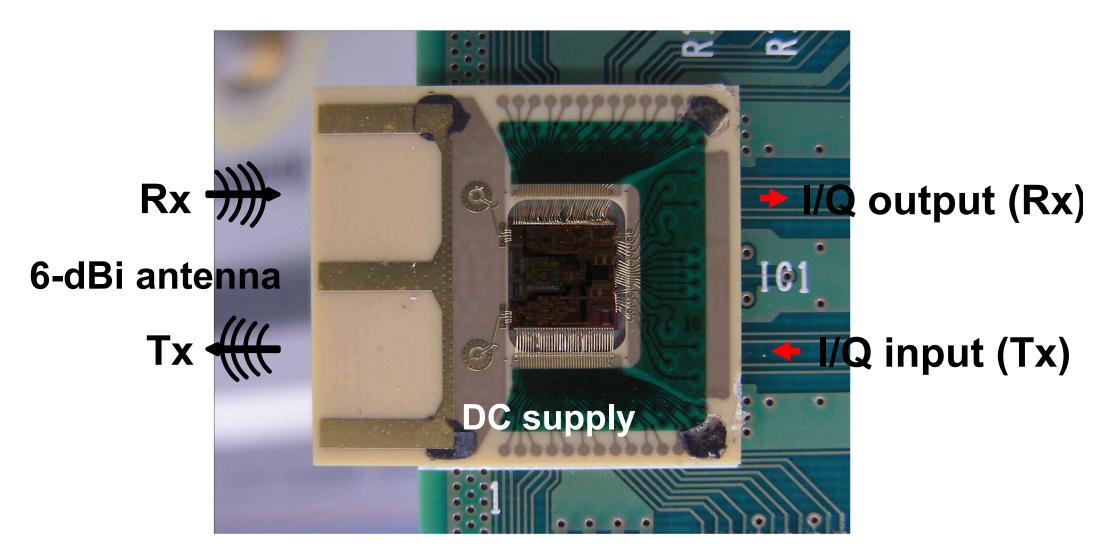
Matsuzawa & Okada Lab.

チップ写真

RFチップとベースバンドチップのVGA, ADC, DAC回路を開発 RFチップ







16.3mm x 14.4mm

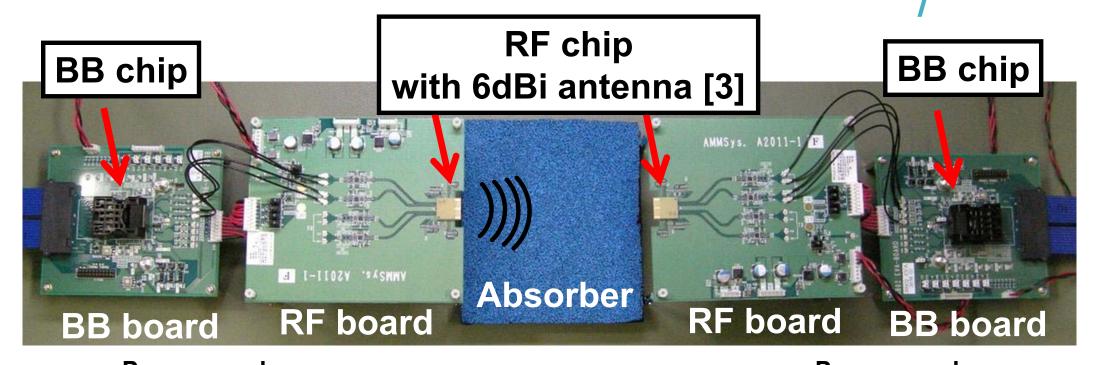
[3] R. Suga, et al., EuMC 2011

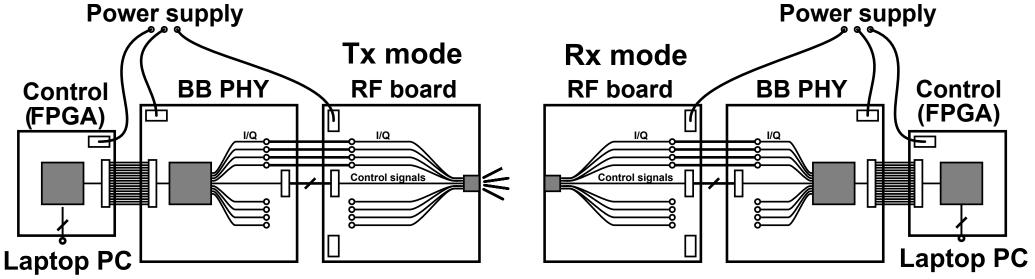


TOKYO TECH

Pursuing Excellence

チップ性能測定系







RF貫通試験 (16QAM)

16QAMでもきれいなコンステレーションが得られた

				•			
Channel/ Carrier freq.	ch.1 58.32GHz	ch.2 60.48GHz	ch.3 62.64GHz	ch.4 64.80GHz	ch.1-ch.4 Max rate		
Modulation			16QAM				
Constellation	老 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *		安全 安安 安安 安安 安安 安安 安安 安安	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Spectrum	10 0 -10 -20 -30 -40 55.08 58.32 61.56	10 0 -10 -20 -30 -40 57.24 60.48 63.72	10 0 -10 -20 -30 -40 59.40 62.64 65.88	10 0 -10 -20 -30 -40 61.56 64.80 68.04	10 0 -10 -20 -30 -40 59.40 62.64 65.88		
Back-off	4.4dB	4.6dB	5.0dB	5.7dB	5.0dB		
Data rate*	7.0Gb/s	7.0Gb/s	7.0Gb/s	7.0Gb/s	10.0Gb/s (ch.3)		
EVM	-23.0dB	-23.0dB	-23.3dB	-22.8dB	-23.0dB (ch.3)		
Distance**	0.3m	0.3m 0.5m 0.5m		0.3m	>0.01m (ch.3)		

^{*}The roll-off factor is 0.25. The bandwidth is 2.16GHz except for Max rate.

**Maximum distance within a BER of 10-3. The 6-dBi antenna in the package is used.



世界初の4チャネル全ての送受が可能なRF+BBチップ 16QAMを用いて6.3Gbpsの超高速伝送を低電力で実現

	Integration	Data rate (16QAM)	Ch.	P _{DC} (Tx/Rx)
CEA-LETI [5]	RF (Hetero)	3.8Gb/s	-	1,357mW / 454mW
SiBeam [6]	RF (Hetero)	3.8Gb/s	Ch.1-2	1,820mW / 1,250mW
Tokyo Tech (This work)	RF (Direct) +analog BB +digital BB	RF+BB: 6.3Gb/s	Ch.1-4	RF:319mW / 223mW BB:196mW / 398mW

[1] K. Okada, et al., ISSCC 2011 [4] H. Asada, et al., A-SSCC 2011 [5] A. Siligaris, et al., ISSCC 2011 [6] S. Emami, et al., ISSCC 2011 [12] C. Marcu, et al., ISSCC 2009



世界最高のデータレートを目指して

世界最高のデータレート(16Gbps)を実現。

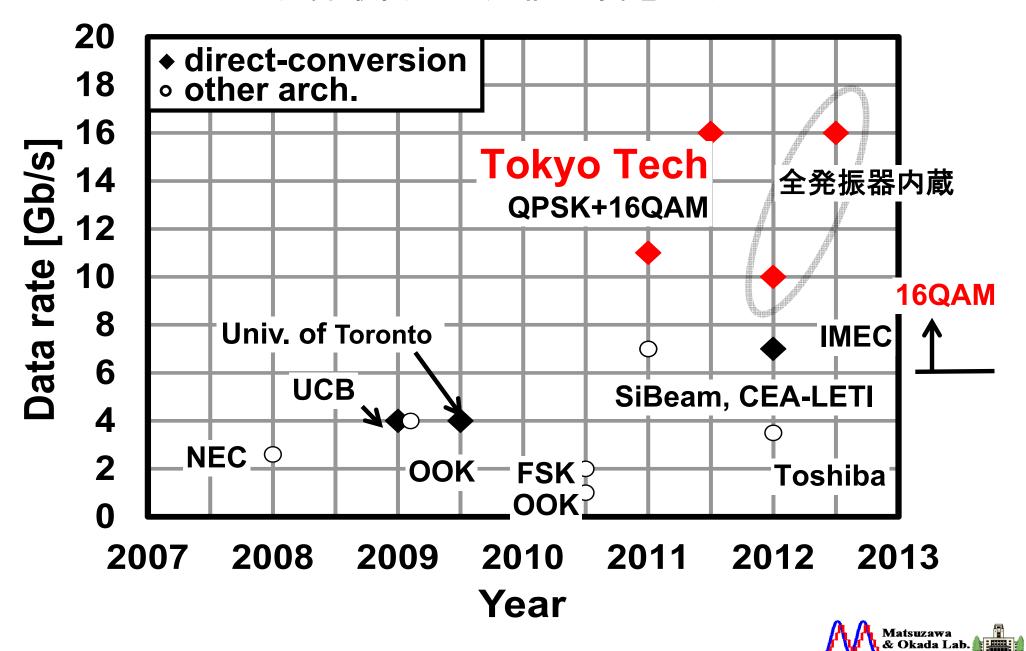
Constellation	9506 points	19912 points	13502 points	42024 points
Modulation	QPSK	16QAM	QPSK	16QAM
Symbol rate	1.76GS/s	1.76GS/s	5.0GS/s	4.0GS/s
Data rate	3.52Gb/s	7.04Gb/s	10.0Gb/s	16.0Gb/s
EVM (withDFE)	-30.5dB	-28.2dB	-15.2dB	-16.1dB

TOKYO TECH

Pursuing Excellence

60GHzフロントエンド性能比較

世界最高速の通信速度を達成



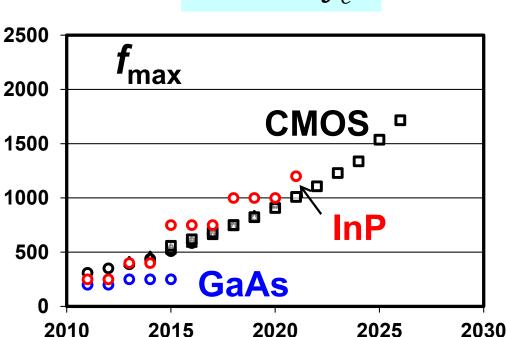
60GHz CMOS RF回路設計のポイント

CMOSの微細化とRF回路性能

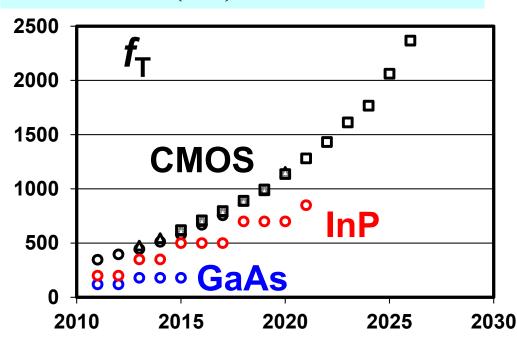
RF回路の基本性能(利得, ノイズ)は最終的にはデバイスの f_T , f_{max} で決まる。微細化によりCMOSの f_T , f_{max} は今後も向上する

NF<4dB at 60GHz はCMOSで達成している

$$G_{
m max} pprox rac{f_{
m max}}{f_c}$$



$$NF_{\min} \approx 1 + \left(\frac{f_c}{f_T}\right) \sqrt{1.3g_m(R_g + R_s)}$$



O Bulk CMOS

▲ Ultra-Thin-Body Fully-Depleted (UTB FD) SOI

■ Multi-Gate MOSFETs

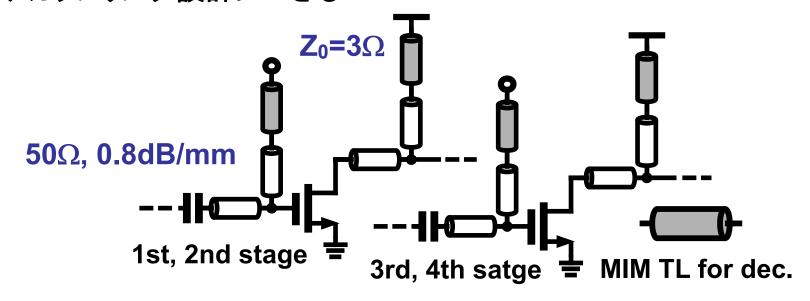
ITRS RFAMS 2011.



TOKYO TEC

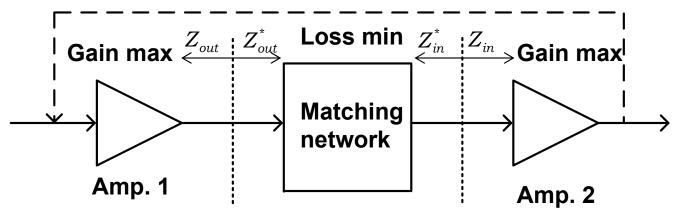
増幅器設計

増幅器設計は、サイズ設定、バイアス設定、インピーダンスマッチング デカップリング設計につきる



フィードバックパスが生じると数GHzで発振が起こる

Feedback pass



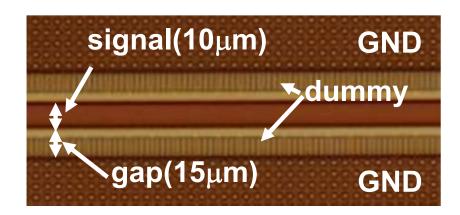


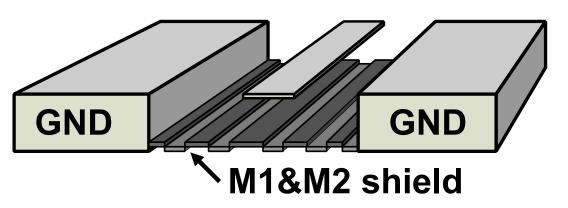
トランスミッションライン技術

トランスミッションライン技術をベースにした、インピーダンス整合回路、トランス、バルン、デカップリング容量を開発した

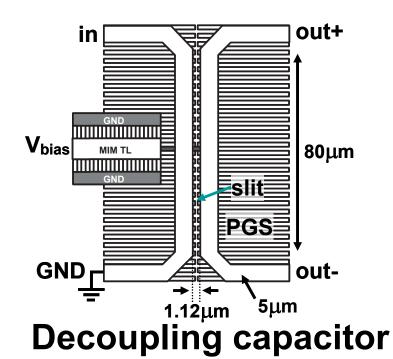
Transmission line

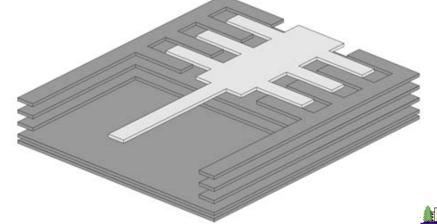
0.8dB/mm Manually-placed dummy metal





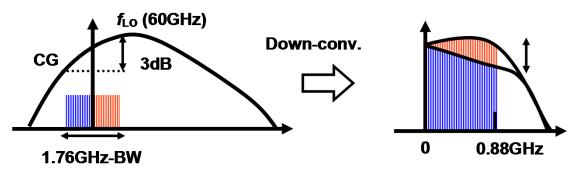
Transformer



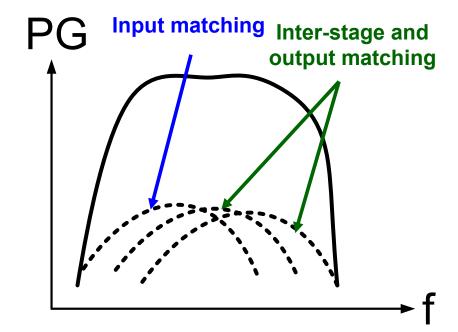


ゲインフラットネス

信号帯域内の周波数特性の偏差があると16QAM信号にISIを生じ、 ビット誤り率が低下する。→整合回路を調整して周波数偏差を抑える。



Gain Flatness	0dB		2dB			3dB					
BER	~0			1.3e-5			3e-3				
Constellation				查線會隊	安安安安	在	秦安安西	安安安衛	華物都衛	海縣縣衛	多类等等

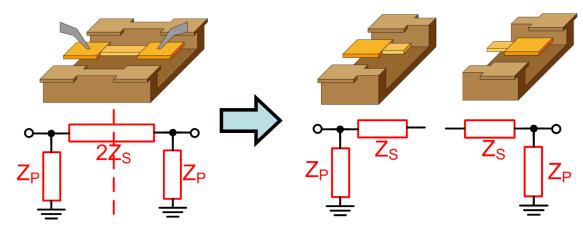


モデリング(デエンベッディング)技術

スルーオンリー法

パッドと付きだし部分を測定

プローブ間干渉により不正確



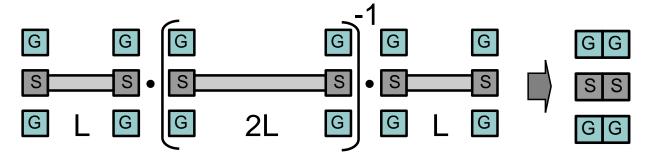
Thru (short line) structure

Pad model

L-2L 法

L (200um)と2L (400um)の伝送線路で測定

パッドのみの等価回路を 導出



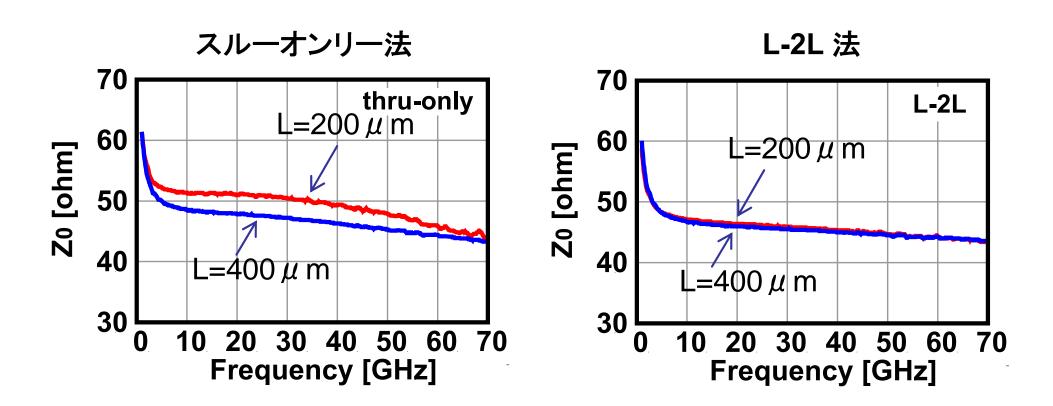
$$\mathbf{T}_{l\mathbf{pad}}\cdot\mathbf{T}_{\mathbf{TL}}\cdot\mathbf{T}_{rp\mathbf{ad}}\cdot\left(\mathbf{T}_{l\mathbf{pad}}\cdot\mathbf{T}_{\mathbf{TL}}\cdot\mathbf{T}_{\mathbf{TL}}\cdot\mathbf{T}_{rp\mathbf{ad}}\right)^{-1}\cdot\mathbf{T}_{l\mathbf{pad}}\cdot\mathbf{T}_{\mathbf{TL}}\cdot\mathbf{T}_{rp\mathbf{ad}} = \mathbf{T}_{l\mathbf{pad}}\cdot\mathbf{T}_{rp\mathbf{ad}}$$

A. M. Mangan, et al., IEEE Trans. on Electron Devices, vol. 53, no. 2, pp.235-241, Feb. 2006 N. Takayama, et al., IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), Singapore, Dec. 2009.



モデリング(デエンベッディング)技術

伝送線路の特性インピーダンスを2つの方法で評価 スルーオンリー法では本来線路長に依らない特性インピーダンスが 線路長により異なっている。L-2L法では一致している。→ L-2L法が精度が高い



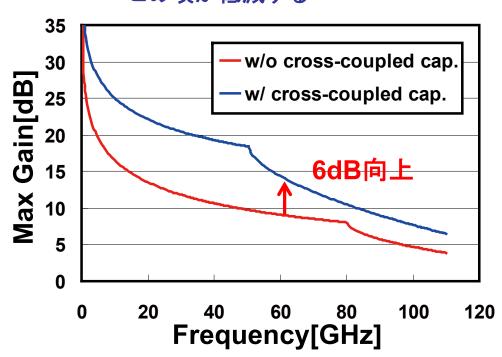
帰還容量キャンセル



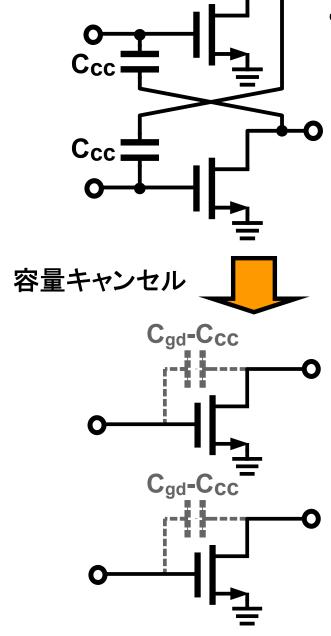
差動回路ではクロスカップル容量により帰還容量を低減できるこれにより60GHzで6dBもの利得アップができる

$$f_{\text{max}} = \frac{f_T}{2\sqrt{R_g g_m C_{gd} / (C_{gs} + C_{gd}) + (R_g + r_{ch} + R_s)g_{ds}}}$$

この項が低減する



Y. Natsukari, et al., VLSI, June 2009. W. L. Chan, et al., ISSCC., Feb. 2009.



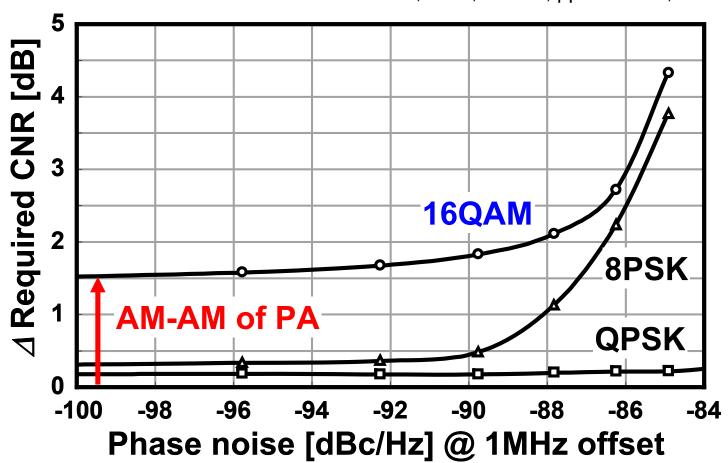


必要な直交発振器の位相ノイズ

16QAMを実現するには-90dBc/Hz@1MHz以下の位相ノイズが必要

それまでの60GHz帯直交発振器は -76dBc/Hz@1MHz程度

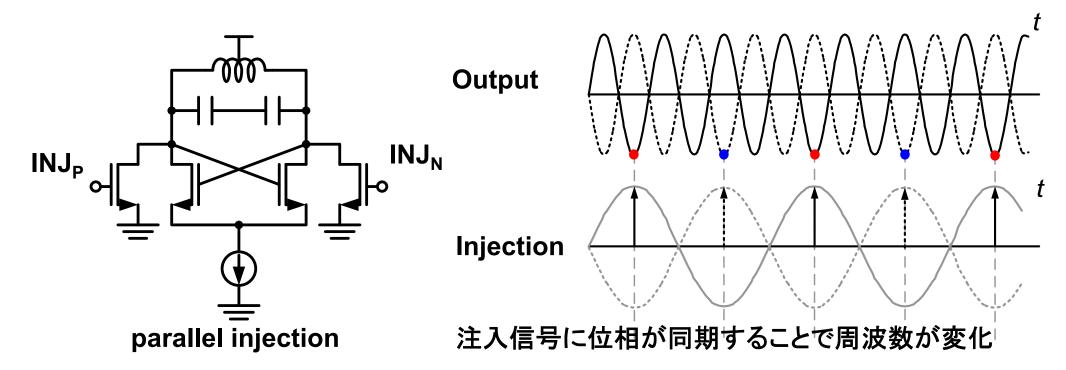
K. Scheir, et al., ISSCC, pp. 494-495, Feb. 2009.





注入同期の原理

注入同期により高い周波数の発振器の位相を、より低い発振器で制御することができる。



- •位相雑音(ジッタ)は注入信号に依存
- •周期が短くなる分、相対的にジッタが大きく見える

逓倍器の位相雑音
$$PN_{
m ILO}=PN_{
m INJ}+20\log(N)$$
 N :逓倍数 ロックレンジ $\Delta\omega_{\scriptscriptstyle L}=rac{\omega_{\scriptscriptstyle o}}{O}\cdotrac{I_{\scriptscriptstyle Inj}}{I_{\scriptscriptstyle LRS}}\cdotrac{1}{\sqrt{I_{\scriptscriptstyle a}}}$ N=3のとき 9.5dB

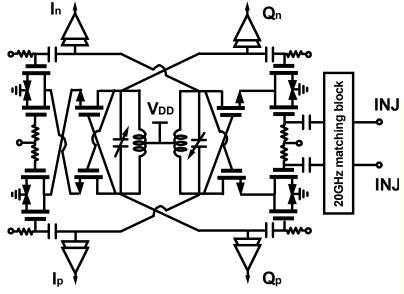


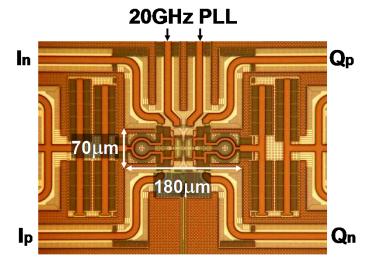
TOKYO TECH

低位相ノイズ直交VCO

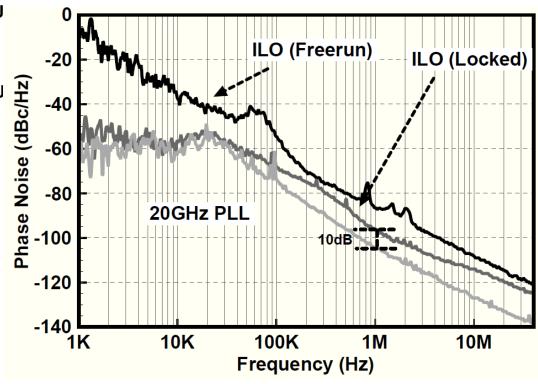
60GHzの直交VCOに20GHzのPLLでインジェクションロックをかけることで -96dBc/Hz@1MHzの良好な低位相ノイズを実現。

ダイレクトコンバージョンや16QAMが可能となった。





それまでの60GHz 直交VCOの位相ノイズは -76dBc/Hz@1MHz程度



A. Musa, K. Okada, A. Matsuzawa, in A-SSCC Dig. Tech. Papers, pp. 101–102, Nov. 2010.



超高速·低電力ADC

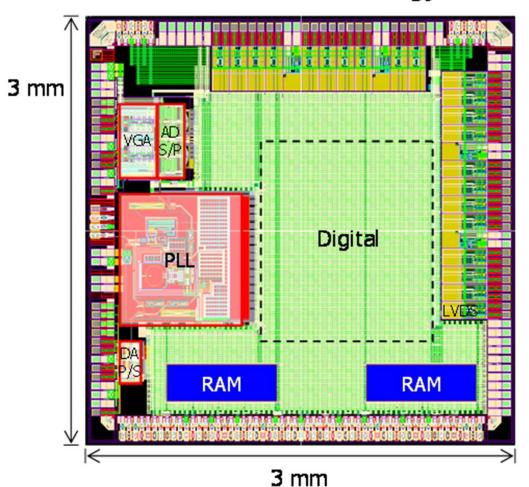
ミリ波ベースバンド用

60GHz帯用ベースバンド SoC

ベースバンドチップはADC, DAC, VGA,とPLLが集積されおり, Pursuing Excellence 40nmCMOSで試作した。(Sonyとの共同開発)

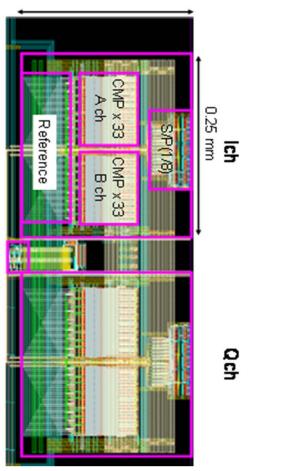
RX: 300mW, TX: 110mW

40nm CMOS technology



ADC 5b, 3GSps, 11mW/ch 当研究室が開発

0.22 mm





高速信号伝送とADC性能

伝送回路のデータレートはADCの分解能Nと変換周波数f_sの積に比例する

$$D_{rate} \approx N \cdot f_s$$
 N: 分解能 f_s : 標本化周波数

ノイズがADCの量子化ノイズで決まると仮定した場合

シャノンの定理

$$C = BW \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

ADCOBW & SNR

$$BW < \frac{f_s}{2} \qquad \frac{P_S}{P_N} \bigg|_{ADC} = 1.5 \cdot 2^{2N} \stackrel{\text{M}}{=}$$

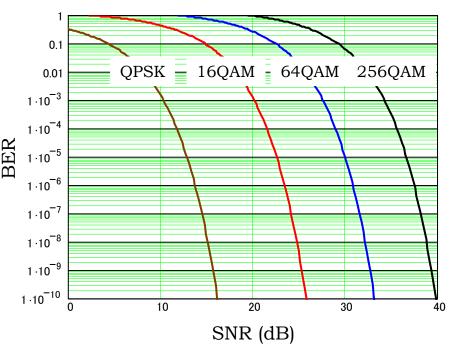
したがって

$$C \approx N f_s$$

f_s: 標本化周波数

N: 分解能

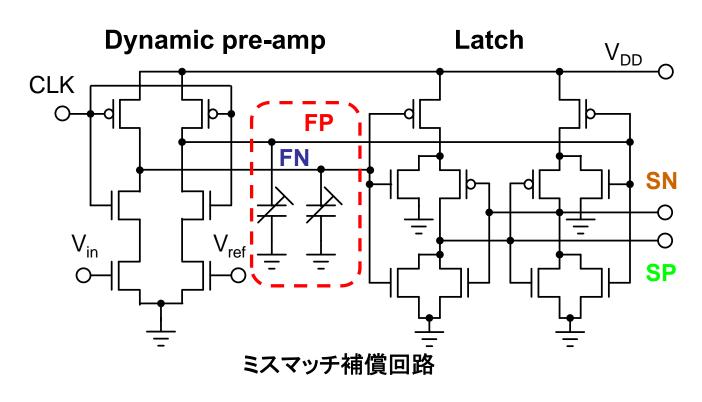
多値変調の実現には高いSNRが必要

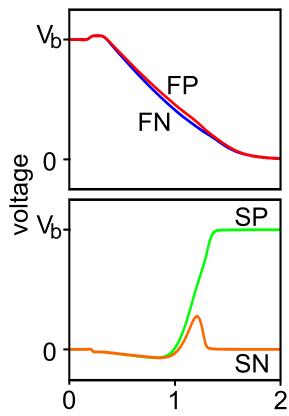


ダイナミック型比較器の開発

ダイナミック型比較器は高速(4GHz程度の動作は容易)であるが 貫通電流が流れず、低電力である。また容量アレーを用いたオフセットミスマッチ補償が容易。

動作波形



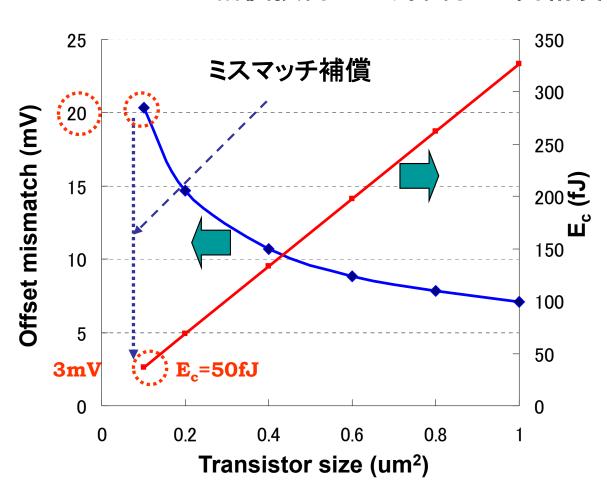


M. Miyahara, and A. Matsuzawa., A-SSCC, 9-2, pp 269-272, Japan, Fukuoka, Nov. 2008.



低電力・高精度比較器の設計

トランジスタサイズを減少させて消費エネルギーを下げ、ミスマッチ電圧の増大はデジタルミスマッチ補償技術により抑制して高精度化する



設計例

6bit ADC: V_{off} <3mV E_C <50fJ \rightarrow 0.1um² \rightarrow V_{off}=20mV Needs mismatch compensation 20mV \rightarrow 3mV

$$V_{
m offset}(\sigma) \propto rac{1}{\sqrt{LW}}$$

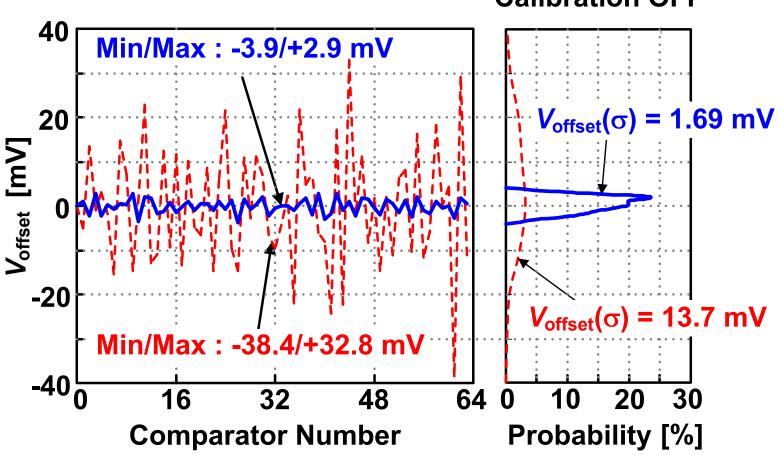
$$E_c \propto C_c \propto LW$$

$$E_c \propto rac{1}{V_{o\!f\!f\!set}^2(\sigma)}$$

オフセット補償結果

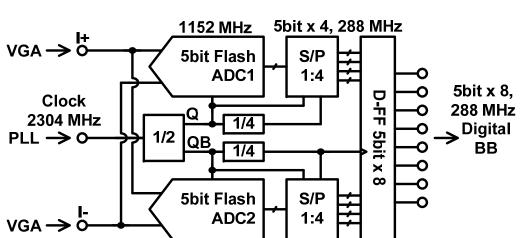




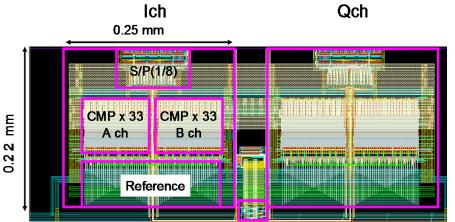




Pursuing Excellence



M. Miyahara and A. Matsuzawa, et al., RFIC 2012.



	0								
В	-10				Fi	n = ′	100	MHz	
Normalized Power [dB]	-20				GΔ	Ga	in =	12	dВ
Vel	-30			L		· Ou	···	14	
8	-30 -40								
<u>Б</u>	-50	1	14.	ب الما	الله	Maria		ا ما	
ze		W		₩₩₩	ካ <mark>ሥ</mark> ሌ			MWIA	14M./N
a E	-60	Ш	1	11 11	 	1111	' 	/ / / /	
Ĩ	-70		•						-
9	-80								
_		0	28	38	57	76	86	4	1152
	Frequency [MHz]								

VGA Gain range	0-40 dB
ADC Resolution	5 bit
Sampling rate	2304 MS/s
Power	VGA: 9 mW
Consumption	ADC : 12 mW*
DNL, INL	< 0.8 LSB
SNDR	26.1 dB
FoM of ADC	316 fJ/convs

*single channel inc. S/P



ADC性能の比較

60GHzトランシーバ用として世界最小レベルの消費電力とコア面積を達成

	Architecture	Cal.	fs [GS/s]	SNDR [dB]	Power [mW]	FoM [fJ/-c.s.]	Process [nm]	Area [mm²]
[1]	Flash	-	3.5	31.2	98	946	90	0.149
[2]	SAR	Internal	2.5	34.0	50	489	45	1
[3]	Folding	Internal	2.7	33.6	50	474	90	0.36
[4]	Pipeline, Folding	External	2.2	31.1	2.6	40	40	0.03
[5]	Flash	Internal	2.88	27.8	36	600	65	0.25
This work	Flash	Internal	2.3	26.1	12	316	40	0.06

[5] T. Ito, et al., A-SSCC 2010



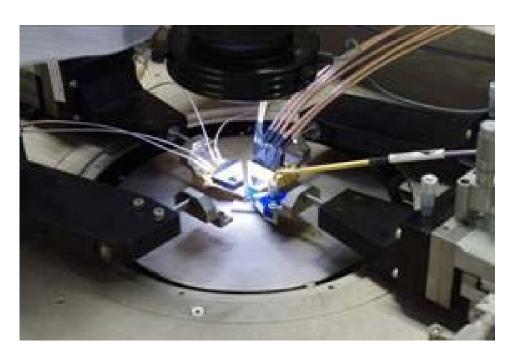
^[1] K. Deguchi, et al., VLSI Circuits 2007 [2] E. Alpman, et al., ISSCC 2009

^[3] Y. Nakajima, et al., VLSI Circuits 2007 [4] B. Verbruggen, et al., ISSCC 2010

研究室の高周波特性評価装置

110GHzまでの最新の高周波評価装置が揃っている





Pursuing Excellence

トランシーバー開発メンバー

修士学生が中心の開発メンバー



2011年1月



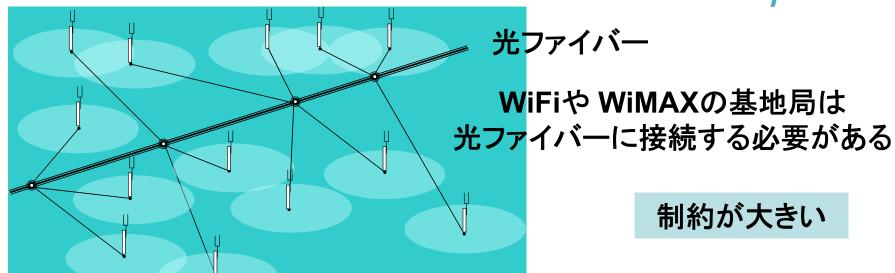
38GHz アウトドアシステム



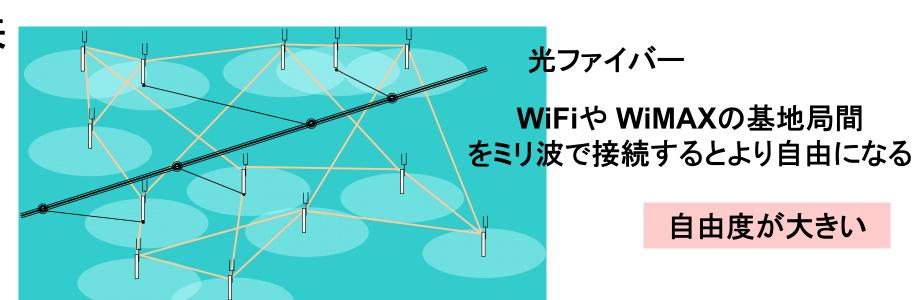
屋外ミリ波システムの役割

TOKYO TECH-Pursuing Excellence

現在



将来





Pursuing Excellence

38GHz 屋外ミリ波システム

1Gbpsの伝送を達成

(それまでは80Mbps)





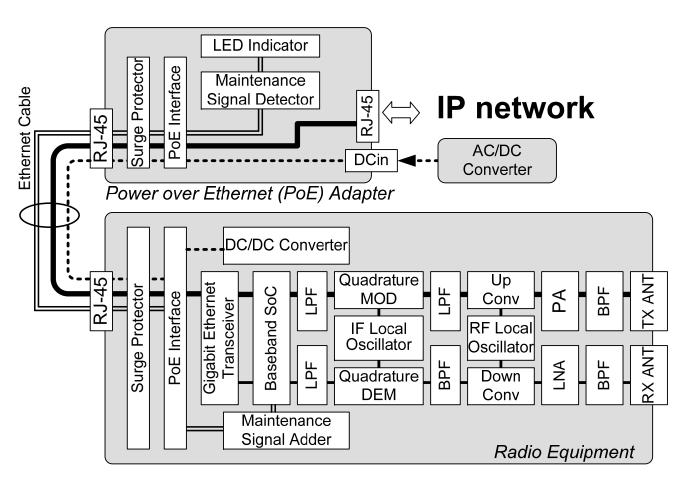


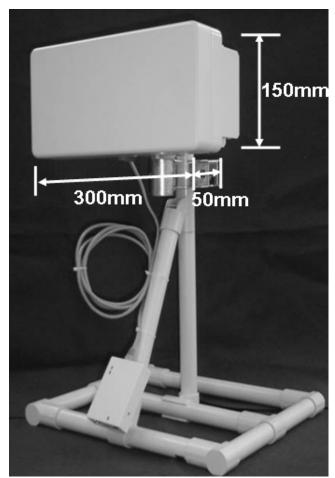


Pursuing Excellence

システム構成

Gb Ethernetとコンパチにシステム 全回路はアンテナ裏面に実装し、極めてコンパクト

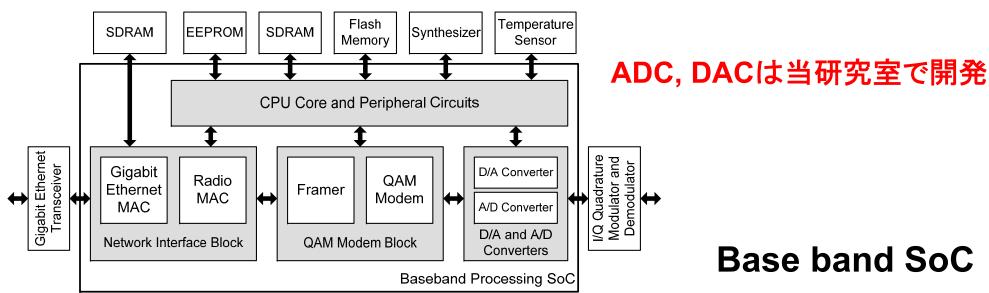


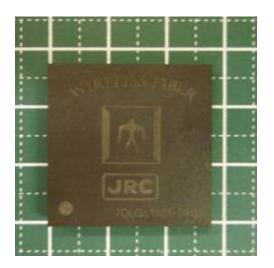


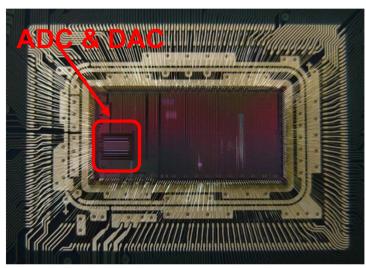


開発したアナ・デジ混載 BB SoC

DSPとADC, DAC混載したSoCを開発 64QAMを用いることで260MHzの帯域で1Gbpsの超高速伝送を実現







Base band SoC

90nm CMOS **40M Transistors**

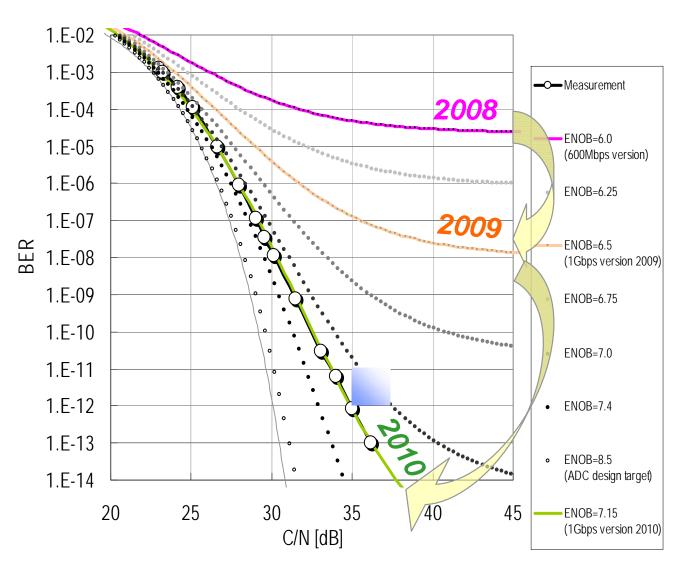


Pursuing Excellence

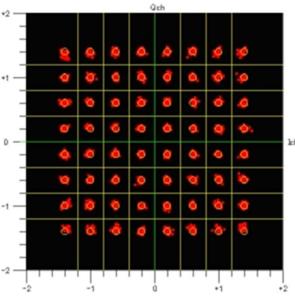
BER vs. SNR

ADCの性能向上(8bit → 10bit)でBER特性を改善 640Mbpsを1Gbpsに向上

C/N vs 64QAM_BER on B-B pair



64QAM



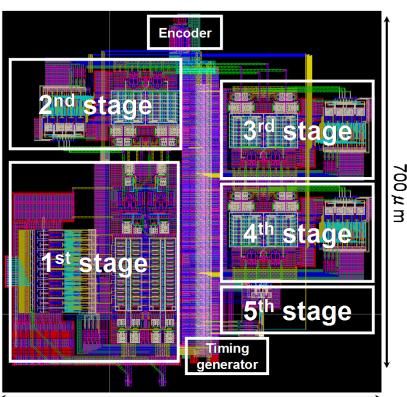


新方式の ADC

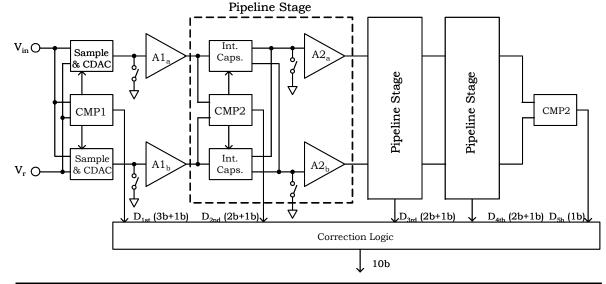
超高速多値伝送に最適の新変換方式の10bit ADCを開発

10b, 320MSps, 30mW ADC

No interleaving
No double sampling
No OpAmp
No calibration



補間パイプライン型ADC



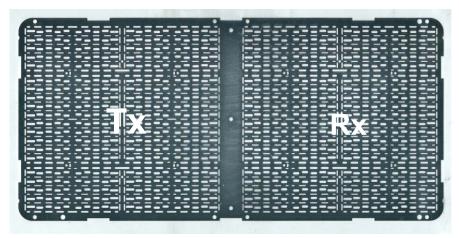
	This Work	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Resolution (bit)	10	10	10	11	10	11
F _{sample} (MHz)	450	500	205	800	1350	1000
V _{DD} (V)	0.8/1.2	1.2	1.0	1.3/1.5	1.2/1.6	1.2/2.5
Power (mW)	40	55	61	350	175	250
ENOB (bit)	8.7	8.5	8.7	8.7	8.0	8.3
FoM (pJ/conv.step)	0.2	0.31	0.65	1.07	0.6	0.77
Technology (nm)	90	90	90	90	130	130
Active Area (mm²)	0.49	0.5	1	1.4	1.6	3.5

M. Miyahara, A. Matsuzawa, VLSI-CS, 2011.



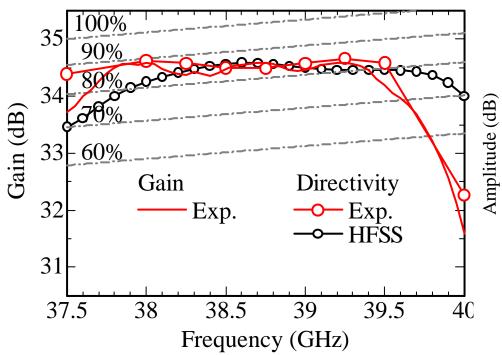
38GHz High gain planar antenna

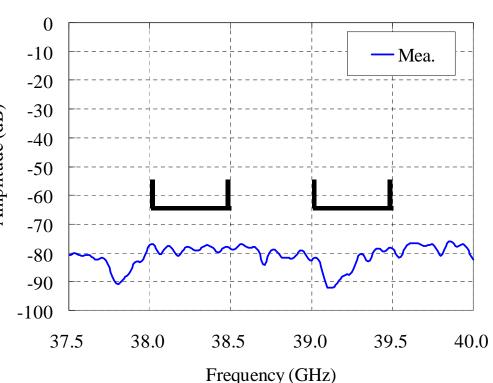
高利得・高アイソレーション平面アンテナを開発



安藤・広川研究室とJRC

Gain: 34.58dBi@38.75GHz Efficiency: 84.9% Tx/Rx Isolation: 75 dB

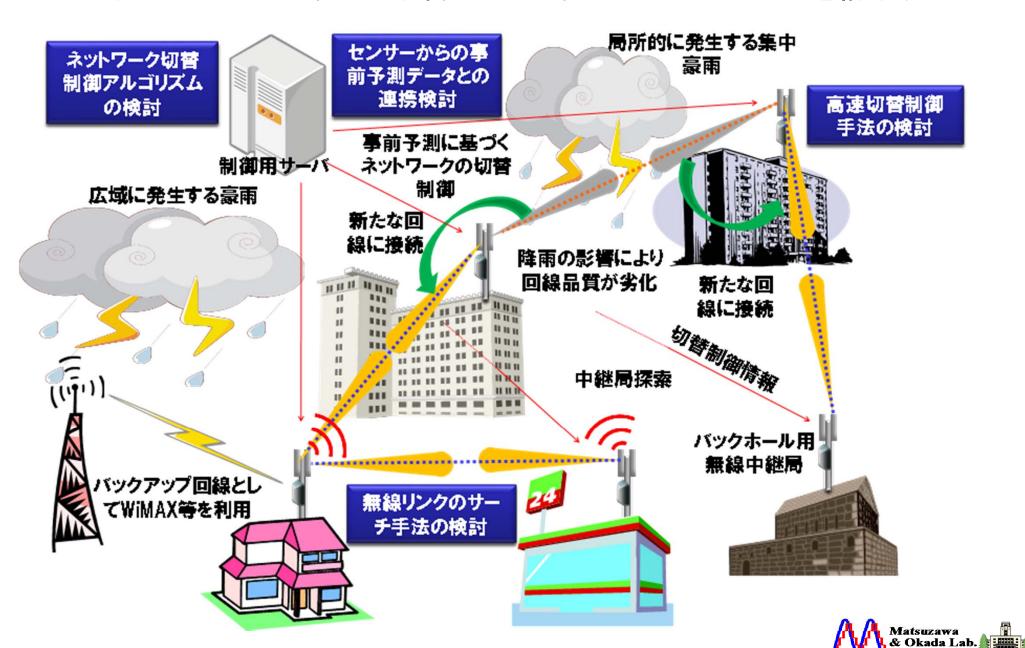




東工大ミリ波モデルネットワーク

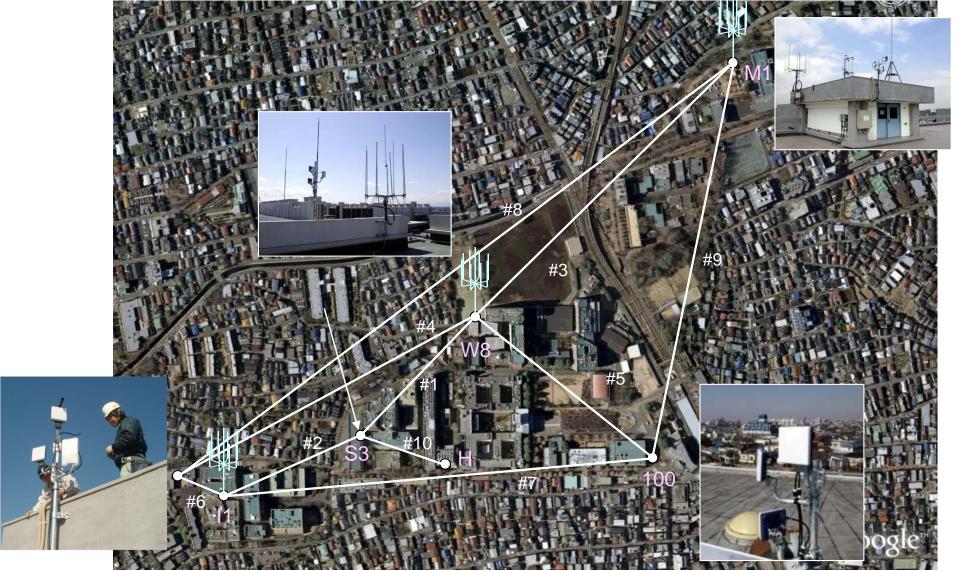
ミリ波ネットワークの課題と対策

ミリ波は降雨に弱いので、適応制御により破綻しないネットワークを構築する



ミリ波中距離モデルネットワーク

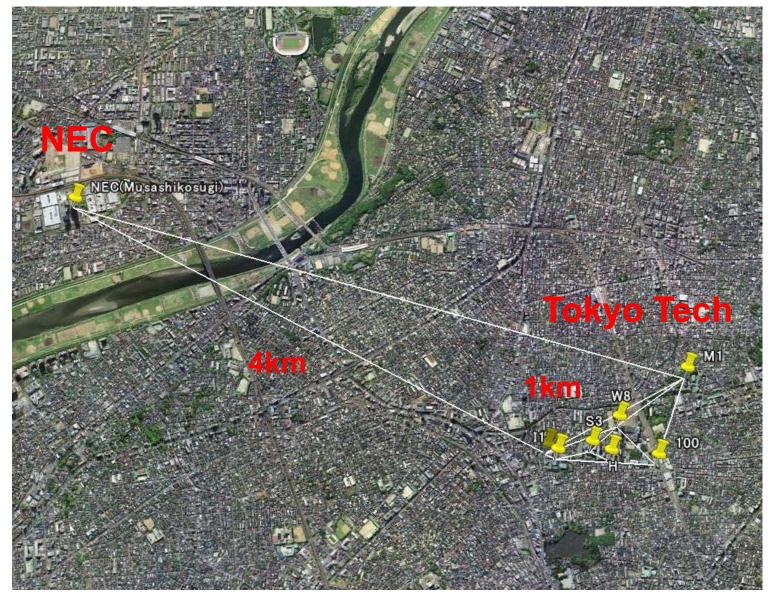
東工大 大岡山キャンパスには10基の中距離ミリ波ステーションがあり 運用実験を行っている



Pursuing Excellence

NEC武蔵小杉 (4km)までの延長

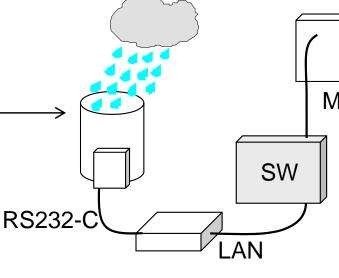
4km ミリ波伝送への挑戦

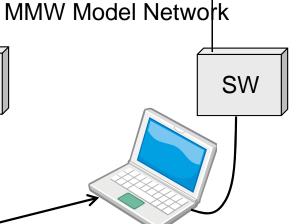


雨量計なども設置し、天候と回線状態をモニター

Tipping-bucket rain gauge







TOKYO TECH

Pursuing Excellence

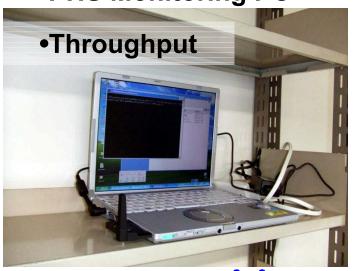
Monitoring PCs

- •Rain rate
- •Rx level
- •BER

(every 5sec)



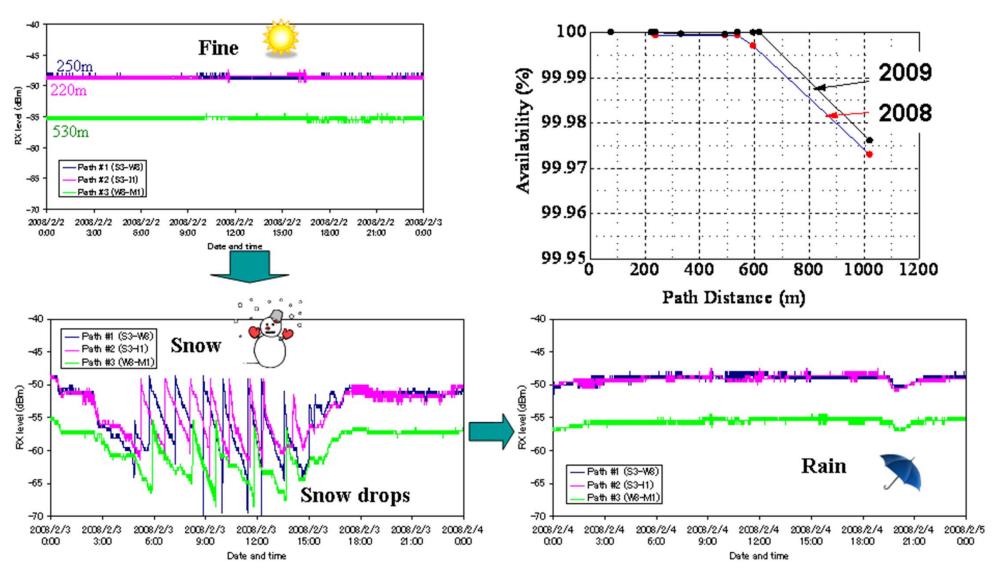
PHS Monitoring PC



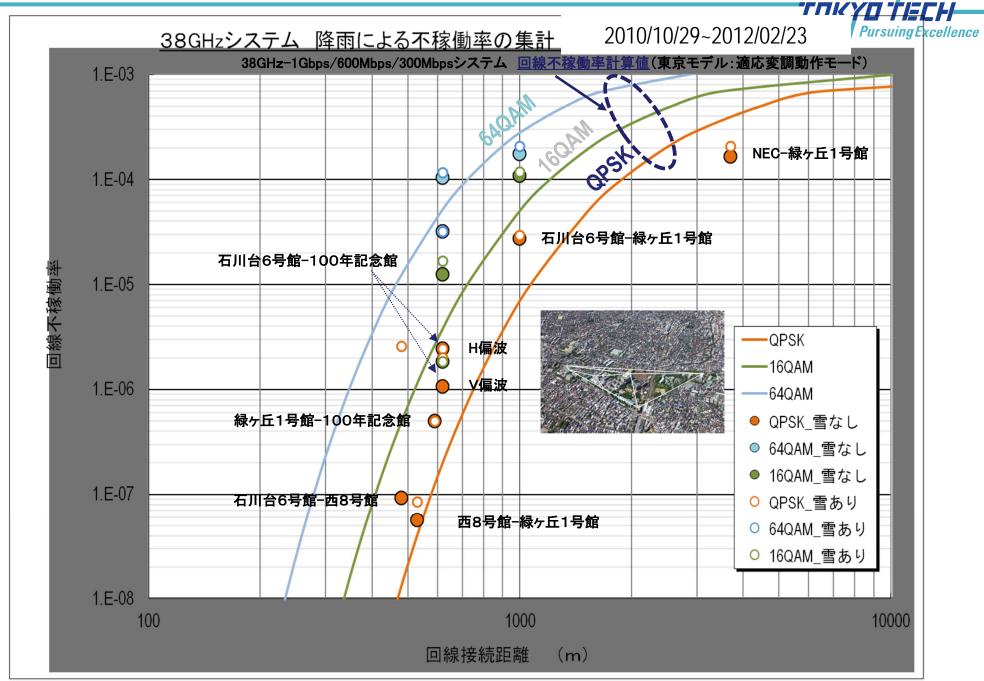


天気による信号強度利用率を調査

ミリ波ネットワークを実際に運用して天候の影響などを調査。
メッシュネットワークにすると、雨でも全ての経路が切断されることは無い。



38G システム回線降雨による不稼働率実測累積プロット



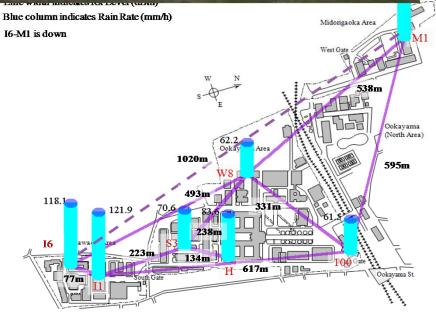


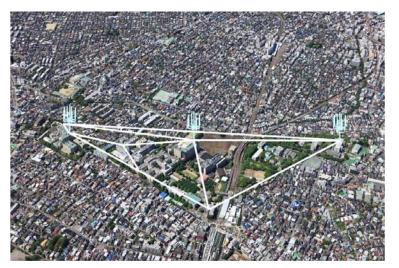
降雨の局所性の振る舞い例





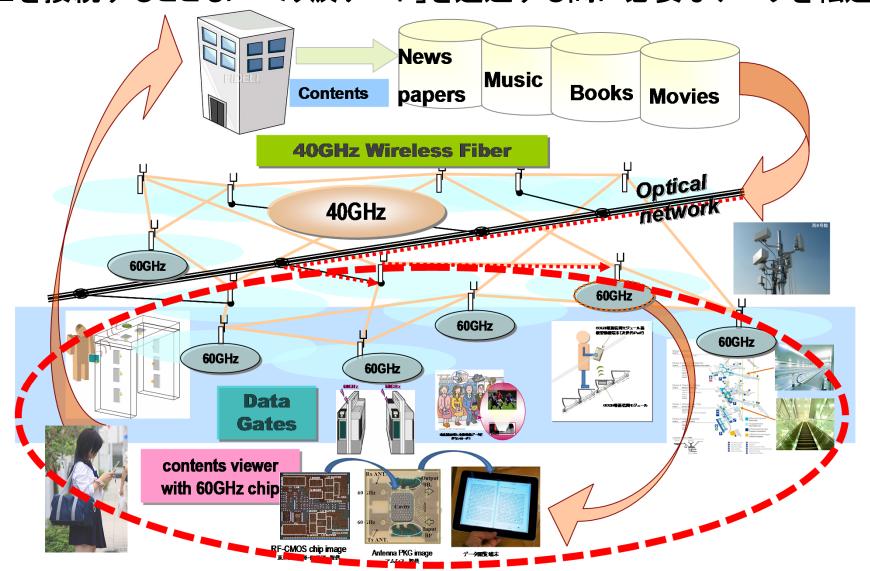








ミリ波は機器間でのデータ転送に使用されるだけでなく、WiFi、WiMaxの基地局間同士を接続するとともに「ミリ波ゲート」を通過する間に必要なデータを転送できる



まとめ

ハードは準備ができた。ミリ波利用モデルの開発が重要はPursuing Excellent

- 超高速ミリ波通信への期待
 - スマホなどによる無線データ量の急増
 - 瞬時の大容量データ転送
- 60GHz帯CMOSトランシーバの開発
 - CMOS微細化によるRF性能の向上とRF/BB一体集積化技術
 - 60GHz 高周波回路, 16QAMなどの多値伝送と数GHzの広帯域化技術
 - インジェクションロック技術などによる低位相ノイズ化技術
 - 超高速·低電力ADC技術
- 大学主体の産学連携開発体制
 - 将来技術のインキュベーション
 - 大学で高性能集積回路設計や,システム試作が可能
 - キャンパスミリ波ネットワークでの運用実証

